

Silicon SP5T 吸收式开关,DC-6 GHz

兼容 PE42452

主要特点

工作频段: DC~6GHz

插损: 1.0 dB 隔离度: 50 dB P-0.1: 35 dBm IIP3: 58 dBm

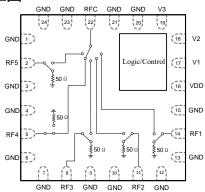
耐功率: +35 dBm (公共端)

+29 dBm (负载端)

ESD: 2kV HBM

封装: 24 Lead, 4mm×4mm QFN

功能框图

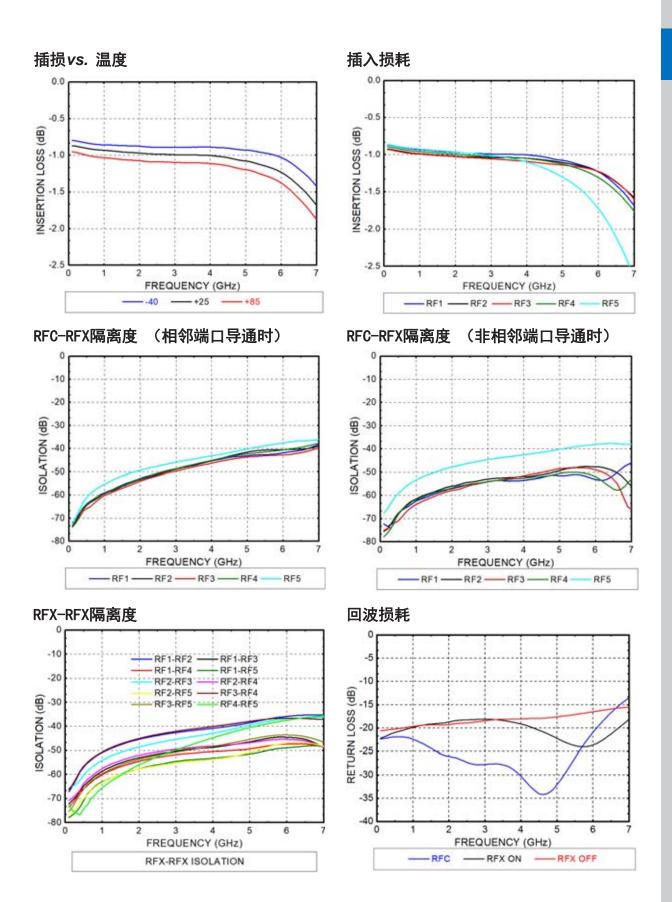


性能指标($T_A = +25^{\circ}C$, $V_{DD}=2.5V \sim 5V$, $V_{CTL}=0V/V_{DD}$, 50Ω)

参数	条件		最小	典型	最大	单位
插损	0.1GHz∼2.0GHz			1	1.4	dB
	2.0GHz∼4.0GHz			1	1.4	dB
	4.0GHz∼6.0GHz			1.2	1.6	dB
隔离度	RFC∼ RF1-RF5	0.1GHz∼2.0GHz	45	55		dB
		2.0GHz∼4.0GHz	40	50		dB
		4.0GHz∼6.0GHz	34	40		dB
隔离	RFX~RFX	0.1GHz∼2.0GHz	42	50		dB
		2.0GHz∼4.0GHz	36	45		dB
		4.0GHz∼6.0GHz	34	40		dB
	开态	0.1GHz∼2.0GHz		20		dB
		2.0GHz∼4.0GHz		20		dB
同处提起		4.0GHz∼6.0GHz		15		dB
回波损耗	关态	0.1GHz∼2GHz		20		dB
		2.0GHz∼4.0GHz		20		dB
		4.0GHz∼6.0GHz		15		dB
开关时间	导通	50% VCTL to 90% RF		270		ns
	关断	50% VCTL to 10% RF		100		ns
输入功率压缩点	P-0.1	VDD=5V		35		dBm
	P-1	VDD=5V		35		dBm
IIP3	POUT=12dBm/tone			58		dBm
工作电压	VDD		2.5	3	5	V
控制电压范围	V1, V2, V3		0		VDD	V
控制电压输入	VDD=+5.0V	低电平(VIL)	0		0.6	V
电平范围		高电平(VIH)	1.1		VDD	V
功耗	VDD=+5.0V			60		μΑ



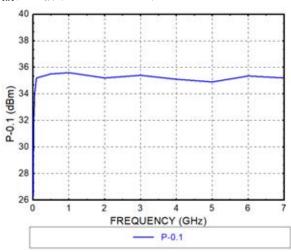
Silicon SP5T 吸收式开关,DC - 6 GHz



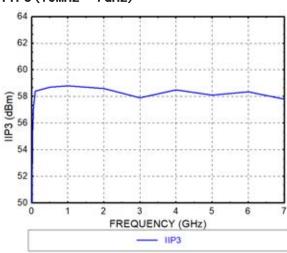


Silicon SP5T 吸收式开关,DC - 6 GHz

输入P-0.1 (10MHz~7GHz)

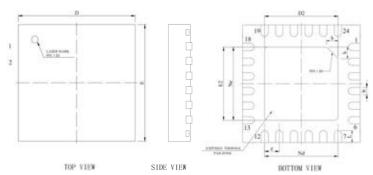


IIP3 (10MHz~7GHz)



封装框架

单位: mm

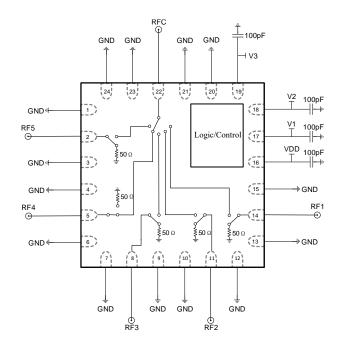


SYMBOL.	MILLIMETER			
DT ADOL	MIN	NOM	MAX	
A	0.65	0.75	0.85	
A1	_	0.02	0.05	
b	0.20	0. 25	0.30	
с	0.18	0. 20	0. 25	
D	3, 90	4.00	4.10	
D2	2. 40	2.50	2.60	
e	0, 50BSC			
Ne	2. 50BSC			
Nd	2. 50BSC			
E	3. 90	4.00	4. 10	
E2	2.40	2.50	2. 60	
L	0.35	0.40	0. 45	
h	0.35	0.40	0.45	



Silicon SP5T 吸收式开关,DC - 6 GHz

应用框图



控制关系

状态	V1	V2	V3
ALL OFF	0	0	0
RFC-RF1 ON	1	0	0
RFC-RF2 ON	0	1	0
RFC-RF3 ON	1	1	0
RFC-RF4 ON	0	0	1
RFC-RF5 ON	1	0	1
ALL OFF	0	1	1
ALL OFF	1	1	1

极限参数

参数	备注	数值	单位
工作电压	VDD	5.5	V
控制电压	V1, V2, V3	5.5	V
射频输入功率	直通	35	dBm
	负载	29	dBm
存储温度	-	- 65∼150	$^{\circ}$
热阻	直通	110	°C/W
	负载	100	°C/W
ESD	НВМ	2	kV